# 主纤维丛结构下材料电阻的动态控制属性建模 与材料筛选反演机制

作者: GaoZheng日期: 2025-05-19

## 一、系统定义

### 1. 状态空间与属性映射

设材料状态空间为:

$$\mathcal{S} = \{\sigma_i \mid i \in I\}$$

每个状态  $\sigma_i$  对应一个属性向量嵌入:

$$P(\sigma_i) = (p_1(\sigma_i), p_2(\sigma_i), \dots, p_d(\sigma_i)) \in \mathbb{R}^d$$

### 2. 微分动力量子定义(压强)

对任意跃迁  $\sigma_i \to \sigma_j$ ,定义微分动力量子为:

$$\mu(\sigma_i, \sigma_i; w) := w \cdot (P(\sigma_i) - P(\sigma_i))$$

其中 $w \in \mathbb{R}^d$ 是可调压强权重向量。

### 3. 路径定义与路径积分逻辑压强

今路径为:

$$\gamma = (\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n)$$

其路径压强逻辑积分为:

$$L(\gamma;w) := \sum_{k=0}^{n-1} anh\left(\mu(\sigma_k,\sigma_{k+1};w)
ight)$$

### 4. 路径电阻定义

路径上的等效电阻函数定义为:

$$R(\gamma;w) := \sum_{k=0}^{n-1} \left[ rac{1}{|\mu(\sigma_k,\sigma_{k+1};w)| + arepsilon} 
ight]$$

其中  $\varepsilon > 0$  为非零正则项,防止局部跃迁能为零。

# 二、材料的动态控制属性定义

### 1. 最小电阻路径定义

设材料状态网络的允许跳跃拓扑为  $T \subset \mathcal{S} \times \mathcal{S}$ , 定义:

$$\gamma^*(\sigma_0;w) := rg\min_{\gamma \in \Gamma_{\sigma_0}} R(\gamma;w)$$

其中  $\Gamma_{\sigma_0}$  是从初态  $\sigma_0$  出发的所有路径集合,满足每步  $(\sigma_k,\sigma_{k+1})\in T$ 。

### 2. 动态控制电导属性

定义材料的**动态控制性电导**为:

$$\sigma_{ ext{dyn}}(\sigma_0;w) := rac{1}{R(\gamma^*(\sigma_0;w);w)}$$

### 3. 电阻偏差反馈修正机制

设实际系统在时间 t 处路径为  $\gamma_t$  , 电阻为:

$$R_t := R(\gamma_t; w_t)$$

若  $|R_t - R(\gamma^*; w_t)| > \delta_R$ ,则触发局部压强修正:

$$w_{t+1} := w_t + \eta \cdot 
abla_w L(\gamma_t; w_t)$$

并重新计算  $\gamma^*$  满足最小电阻条件。

# 三、材料结构反演 (寻找最优构成)

### 1. 给定目标:

$$\sigma_{
m dyn}^{
m target} > \lambda$$

目标为寻找满足:

$$\exists P: \mathcal{S} 
ightarrow \mathbb{R}^d, \quad$$
使得  $rac{1}{R(\gamma^*(\sigma_0;w))} > \lambda$ 

### 2. 反演求解结构域:

定义属性空间中一类候选属性构型为:

$$\mathcal{P}_{\lambda} := \left\{ P \mid \exists \gamma, \; R(\gamma; w) < rac{1}{\lambda}, \; \gamma = rg \min R(\cdot; w) 
ight\}$$

对任意  $P \in \mathcal{P}_{\lambda}$ ,均可视为潜在室温超导或超流材料构型。

### 3. 材料构成演化过程:

在材料的构成参数空间(如元素比例、晶格结构、缺陷分布等)中定义属性映射族:

$$P = P(x_1, x_2, \dots, x_m)$$

求解参数族  $\vec{x} \in \mathbb{R}^m$ , 使得:

$$P(ec{x}) \in \mathcal{P}_{\lambda}$$

即为最优材料合成路径的控制解。

# 四、系统整合方程

#### 材料的动态控制属性函数为:

$$\sigma_{ ext{dyn}}(\sigma_0;w) := \max_{\gamma \in \Gamma_{\sigma_0}} \left\{ \left( \sum_{k=0}^{n-1} rac{1}{|\mu(\sigma_k,\sigma_{k+1};w)| + arepsilon} 
ight)^{-1} 
ight\}$$

#### **电阻最优路径演化方程**为:

$$rac{dw}{dt} = \eta \cdot 
abla_w L(\gamma_t; w) \quad ext{iff} \quad |R_t - R(\gamma^*)| > \delta_R$$

#### 材料反向设计问题为:

$$\min_{ec{x} \in \mathbb{R}^m} \left[ R(\gamma^*(P(ec{x})); w) 
ight] \quad ext{s.t.} \quad P(ec{x}) \in \mathcal{P}_{\lambda}$$

#### 许可声明 (License)

Copyright (C) 2025 GaoZheng

本文档采用知识共享-署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议 (CC BY-NC-ND 4.0)进行许可。